МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по УР
_____Ким М.Ю.
«29» _____10_____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.04 Электроника и наноэлектроника**
Направленность (профиль) / специализация: **Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **Институт радиоэлектронной техники (ИРЭТ)**
Кафедра: **институт радиоэлектронной техники (ИРЭТ)**
Курс: **4**
Семестр: **7**
Учебный план набора 2026 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	34	34	часов
Практические занятия	28	28	часов
Самостоятельная работа	10	10	часов
Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	108	108	часов
	3	3	з.е.

Формы промежуточной аттестации	Семестр
Экзамен	7

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ким М.Ю.
Должность: Директор департамента по УР
Дата подписания: 29.10.2025
Уникальный программный ключ:
ed789cd8-2cc6-4431-a59e-8f386b1d44fa

Томск

Согласована на портале № 84191

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Приобретение теоретических и практических навыков необходимых для проектировании, измерения и конструирования изделий микроэлектроники и микросистемной техники.

1.2. Задачи дисциплины

1. Изучить конструктивные особенности элементов гибридных и полупроводниковых интегральных схем, а также элементов микросистемной техники.
2. Изучить основные этапы, а также набор конструкторской документации при проектировании гибридных и полупроводниковых интегральных схем, а также элементов микросистемной техники.
3. Изучить материалы, применяемые при изготовлении гибридных и полупроводниковых интегральных схем, а также элементов микросистемной техники.
4. Освоить базовые методики проектирования элементов микроэлектроники и микросистемной техники.
5. Освоить базовые методики измерения элементов микроэлектроники и микросистемной техники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02.12.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
-	-	-
Общепрофессиональные компетенции		
-	-	-
Профессиональные компетенции		

Согласована на портале № 84191

ПК-1. Способен строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования	ПК-1.1. Знает простейшие физические и математические модели электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также стандартные программные средства для физического и математического моделирования электронных приборов и устройств различного функционального назначения	Знает базовые физические и математические модели приборов и устройств микроэлектроники и микросистемной техники различного функционального назначения
	ПК-1.2. Умеет строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования	Умеет использовать базовые программные продукты для расчета и моделирования приборов и устройств микроэлектроники и микросистемной техники различного функционального назначения
	ПК-1.3. Владеет навыками построения простейших физических и математических моделей приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использования стандартных программных средств их компьютерного моделирования	Владеет базовыми навыками построения физических и математических моделей приборов и устройств микроэлектроники и микросистемной техники различного функционального назначения, а также способен применять на практике программное обеспечение для их моделирования и расчета

Согласована на портале № 84191

ПК-5. Способен к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области производства изделий микроэлектроники и твердотельной электроники	ПК-5.1. Знает методологию проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области производства изделий микроэлектроники и твердотельной электроники	Знает базовые методики проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области проектирования и производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники
	ПК-5.2. Умеет составлять техническое задание на проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области производства изделий микроэлектроники и твердотельной электроники	Умеет составлять техническое задание на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки и производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники
	ПК-5.3. Владеет навыками составления рабочего плана проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области производства изделий микроэлектроники и твердотельной электроники	Владеет базовыми навыками проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки и изготовления изделий микроэлектроники и микросистемной техники
ПК-8. Способен владеть современными методами расчета и проектирования изделий микроэлектроники и твердотельной электроники, способностью к восприятию, разработке и критической оценке новых способов их проектирования	ПК-8.1. Знает принципы проектирования изделий электронной техники	Знает базовые принципы проектирования изделий микроэлектроники и микросистемной техники.
	ПК-8.2. Умеет рассчитывать параметры и характеристики приборов и устройств микроэлектроники и твердотельной электроники	Умеет проводить расчет и проектирование изделий микроэлектроники и микросистемной техники
	ПК-8.3. Владеет навыками работы в прикладных программах для расчета и проектирования электронных устройств	Владеет базовыми навыками работы в программах для проектирования изделий микроэлектроники и микросистемной техники

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		7 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	62	62

Согласована на портале № 84191

Лекционные занятия	34	34
Практические занятия	28	28
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	10	10
Подготовка к тестированию	7	7
Подготовка к контрольной работе	3	3
Подготовка и сдача экзамена	36	36
Общая трудоемкость (в часах)	108	108
Общая трудоемкость (в з.е.)	3	3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
7 семестр					
1 Введение	2	2	-	4	ПК-1, ПК-5
2 Конструкции и расчет элементов тонкопленочных гибридных микросхем	6	10	2	18	ПК-1, ПК-5, ПК-8
3 Проектирование топологии тонкопленочных гибридных микросхем	4	6	2	12	ПК-1, ПК-5, ПК-8
4 Конструкции и расчет элементов толстопленочных гибридных микросхем	2	-	1	3	ПК-1
5 Проектирование топологии толстопленочных гибридных микросхем	2	-	-	2	ПК-1, ПК-5
6 Основные элементы топологии полупроводниковых микросхем	6	10	2	18	ПК-1, ПК-5, ПК-8
7 Изоляция элементов в полупроводниковых интегральных схемах	6	-	1	7	ПК-1, ПК-5, ПК-8
8 Основы цифровой электроники. Базовые логические элементы	4	-	1	5	ПК-1, ПК-5, ПК-8
9 Элементы миросистем	2	-	1	3	ПК-1
Итого за семестр	34	28	10	72	
Итого	34	28	10	72	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
7 семестр			

Согласована на портале № 84191

1 Введение	Основные проблемы и задачи курса. Классификация микросхем по функциональным, структурным и конструкторско-технологическим признакам. Система условных обозначений микросхем. Маркировка.	2	ПК-1
	Итого	2	
2 Конструкции и расчет элементов тонкопленочных гибридных микросхем	Виды подложек. Конструкции и расчет тонкопленочных резисторов. Конструкции и расчет тонкопленочных конденсаторов. Конструкции резисторов и конденсаторов с плавной и ступенчатой подгонкой номиналов. Конструкции и расчет тонкопленочных индуктивностей. Расчет пленочных проводников и контактных площадок. Конструкции навесных компонентов. Конструкции и расчет СВЧ ГИС.	6	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	6	
3 Проектирование топологии тонкопленочных гибридных микросхем	Особенности топологии тонкопленочных гибридных ИС и этапы ее расчета и проектирования. Паразитные связи в гибридных микросхемах. Расчет теплового режима гибридной микросхемы. Расчет зон теплового влияния. Герметизация ИМС. Требования к герметизации. Типы корпусов. Разварка корпуса. Способы разварки. Герметизация корпусов, способы. Контроль герметизации корпусов. Конструкторская документация.	4	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	4	
4 Конструкции и расчет элементов толстопленочных гибридных микросхем	Типы подложек толстопленочных гибридных микросхем. Конструкции и расчет толстопленочных резисторов. Конструкции и расчет толстопленочных конденсаторов. Расчет пленочных проводников и контактных площадок. Конструкции навесных компонентов.	2	ПК-1
	Итого	2	
5 Проектирование топологии толстопленочных гибридных микросхем	Особенности топологии толстопленочных гибридных ИС и этапы ее проектирования. Материалы применяемые в толстопленочной технологии. Технологический процесс изготовления толстопленочной ИС. Подгонка номиналов элементов.	2	ПК-1, ПК-5
	Итого	2	

Согласована на портале № 84191

6 Основные элементы топологии полупроводниковых микросхем	Подложки полупроводниковых микросхем. Основные элементы реализуемые в полупроводниковой технологии, их конструкции, расчет и параметры: интегральные транзисторы n-p-n и p-n-p, многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы, транзисторы супер бетта, составные транзисторы (схема Дарлингтона, схема Шиклаи, каскодные схемы), интегральные диоды на основе p-n перехода, интегральные диоды Шоттки, транзисторы с диодом Шоттки, интегральные конденсаторы, интегральные резисторы, интегральные МДП-транзисторы, комплементарные пары. Тестовые элементы. Фигуры совмещения. Базовые технологии измерения параметров диффузионных слоев. Межоперационный контроль. Разработка топологии полупроводниковых ИМС. Правила проектирования топологии ИМС.	6	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	6	
7 Изоляция элементов в полупроводниковых интегральных схемах	Методы изоляции элементов ИМС. Диодная изоляция. Коллекторная изолирующая диффузия. Базовая изолирующая диффузия. Метод самоизоляции n-областью. Метод трех фотошаблонов. Изоляция тонкой пленкой диэлектрика. Декаль-метод. Метод балочных выводов. Изопланар. Полипланар. Эпипланар. Правила проектирования изолированных областей. Правила размещения элементов ИМС на площади кристалла. Методы исследования параметров диффузионных областей	6	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	6	

Согласована на портале № 84191

8 Основы цифровой электроники. Базовые логические элементы	Системы счисления. Основные логические функции. Система условных обозначений (DIN, ANSI, ГОСТ). Эквивалентные схемы. Посчледовательные и комбинационные устройстваю Правило Де Моргана. Таблица Карно. Основные производные функции. Схемотехническая и топологическая реализация основных логических функций (резисторно-транзисторная логика (РТЛ), резисторно-емкостная транзисторная логика (РЕТЛ), диодная логика (ДЛ), диодно- транзисторная логика (ДТЛ), транзисторно- транзисторная логика (ТТЛ), транзисторно- транзисторная логика с диодами Шоттки(ТТЛШ), интегрально-инжекционная логика (И2Л), инжекционно-полевая логика (ИПЛ), эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ), комплементарная МОП логика, МОП логика. Методы определения параметров и характеристик логических элементов	4	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	4	
9 Элементы миросистем	Микроэлектромеханические системы (МЭМС). Фотонные кристаллы. Датчики. Сенсоры. Биочипы. Биореакторы. «Лаборатория на кристалле».	2	ПК-1
	Итого	2	
Итого за семестр		34	
Итого		34	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр			
1 Введение	Система условных обозначений микросхем. Маркировка.	2	ПК-1, ПК-5
	Итого	2	
2 Конструкции и расчет элементов тонкопленочных гибридных микросхем	Расчет конструкции тонкопленочных резисторов	4	ПК-1, ПК-8
	Расчет конструкции тонкопленочных конденсаторов	2	ПК-1
	Проведение контрольной работы по расчету тонкопленочных резисторов	2	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Проведение контрольной работы по расчету конструкции тонкопленочных конденсаторов	2	ПК-1, ПК-8
	Итого	10	

Согласована на портале № 84191

3 Проектирование топологии тонкопленочных гибридных микросхем	Расчет паразитных связей в гибридных микросхемах	2	ПК-1
	Расчет тепловых режимов элементов гибридных микросхем	2	ПК-1
	Проведение контрольной работы по тепловому расчету ГИС	2	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	6	
6 Основные элементы топологии полупроводниковых микросхем	Расчет конструкции n-p-n транзисторов	4	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Контрольная работа по расчету n-p-n транзистора	2	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Расчет диффузионного резистора	2	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Контрольная работа по расчету конструкции диффузионного резистора	2	ПК-1, ПК-5, ПК-8
	Итого	10	
Итого за семестр		28	
Итого		28	

5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
7 семестр				
1 Введение	Подготовка к тестированию	0	ПК-1, ПК-5	Тестирование
	Итого	0		
2 Конструкции и расчет элементов тонкопленочных гибридных микросхем	Подготовка к контрольной работе	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Контрольная работа
	Подготовка к тестированию	1	ПК-1, ПК-8	Тестирование
	Итого	2		
3 Проектирование топологии тонкопленочных гибридных микросхем	Подготовка к тестированию	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Контрольная работа
	Итого	2		

Согласована на портале № 84191

4 Конструкции и расчет элементов толстопленочных гибридных микросхем	Подготовка к тестированию	1	ПК-1	Тестирование
	Итого	1		
5 Проектирование топологии толстопленочных гибридных микросхем	Подготовка к тестированию	0	ПК-1, ПК-5	Тестирование
	Итого	0		
6 Основные элементы топологии полупроводниковых микросхем	Подготовка к контрольной работе	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Контрольная работа
	Подготовка к тестированию	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Тестирование
	Итого	2		
7 Изоляция элементов в полупроводниковых интегральных схемах	Подготовка к тестированию	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Тестирование
	Итого	1		
8 Основы цифровой электроники. Базовые логические элементы	Подготовка к тестированию	1	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Тестирование
	Итого	1		
9 Элементы миросистем	Подготовка к тестированию	1	ПК-1	Тестирование
	Итого	1		
Итого за семестр		10		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		46		

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности			Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Сам. раб.	
ПК-1	+	+	+	Контрольная работа, Тестирование, Экзамен
ПК-5	+	+	+	Контрольная работа, Тестирование, Экзамен
ПК-8	+	+	+	Контрольная работа, Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Согласована на портале № 84191

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
7 семестр				
Контрольная работа	10	10	20	40
Тестирование	10	10	10	30
Экзамен				30
Итого максимум за период	20	20	30	100
Нарастающим итогом	20	40	70	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 – 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Проектирование электронной компонентной базы микроэлектроники и микросистемной техники: Учебное пособие / А. А. Жигальский - 2025. 201 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/11209.

2. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок : Учебник для вузов / Л. А. Коледов. - М. : Радио и связь, 1989. - 400 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 48 экз.).

3. Терехов, А. И. Технологические основы изготовления интегральных микросхем : учебное пособие / А. И. Терехов, И. А. Тихомирова. — Иваново : ИГЭУ, 2018. — 116 с [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/154591.

4. Гридчин А.В. Микро датчики и микросистемы. Краткий курс лекций: учебное пособие / А. В. Гридчин. - Новосибирск: Изд-во НГТУ. 2021. - 226 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/216290#2.

7.2. Дополнительная литература

Согласована на портале № 84191

1. Справочное пособие по конструированию микросхем : справочное издание / Э. А. Матсон, Д. М. Крыжановский. - Минск : Вышэйшая школа, 1982. - 224 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 22 экз.).

2. Конструкции и технология микросхем : Учебное пособие для вузов / Э. А. Матсон. - Минск : Вышэйшая школа, 1985. - 206 с (наличие в библиотеке ТУСУР - 49 экз.).

3. Воробьев,Н. И. Проектирование электронных устройств : учебное пособие для вузов / Н. И. Воробьев. - М. : Высшая школа, 1989. - 223 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 32 экз.).

4. Бубенников А.Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и схем : Учебное пособие для вузов / А. Н. Бубенников. - М. : Высшая школа, 1989. - 319, [1] с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 35 экз.).

5. Технология и конструирование интегральных микросхем : Учебное пособие для вузов / А. С. Березин, О. Р. Мочалкина ; ред. : И. П. Степаненко. - М. : Радио и связь, 1983. - 232 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 49 экз.).

6. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : Учебное пособие для вузов / Иван Ефимович Ефимов, Иван Яковлевич Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1987. - 416 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 27 экз.).

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Проектирование электронной компонентной базы микроэлектроники и микросистемной техники: Учебно-методическое пособие по практическим занятиям и самостоятельной работе студентов / А. А. Жигальский - 2025. 40 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/11212.

2. Матсон Э.А. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА : Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие для вузов / Э. А. Матсон, Д. В. Крыжановский, В. И. Петкевич. - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 192 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 28 экз.).

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие

Согласована на портале № 84191

тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебная аудитория: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 222 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Компьютер Intel(R) Core (TM)2 CPU;
- Проектор Benq;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 101 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 107 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 130 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля

Согласована на портале № 84191

и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)
1 Введение	ПК-1, ПК-5	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
2 Конструкции и расчет элементов тонкопленочных гибридных микросхем	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
3 Проектирование топологии тонкопленочных гибридных микросхем	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
4 Конструкции и расчет элементов толстопленочных гибридных микросхем	ПК-1	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
5 Проектирование топологии толстопленочных гибридных микросхем	ПК-1, ПК-5	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
6 Основные элементы топологии полупроводниковых микросхем	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
7 Изоляция элементов в полупроводниковых интегральных схемах	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
8 Основы цифровой электроники. Базовые логические элементы	ПК-1, ПК-5, ПК-8	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Согласована на портале № 84191

9 Элементы миросистем	ПК-1	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.

Согласована на портале № 84191

4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Какие из резистивных материалов применяются при изготовлении высокоомных резисторов?
   а) керметы
   б) сплавы
   в) чистые металлы
2. Какому классу чистоты должны соответствовать подложки, применяемые в тонкопленочной технологии?
   а) 14
   б) 10
   в) 8
3. Какие из резистивных материалов не применяется при изготовлении термостабильных резисторов?
   а) керметы
   б) сплавы
   в) чистые металлы
4. Если шаг координатографа 1 мм, а масштаб 10:1, то какой будет топологическая ширина резистора, если bтехн=300 мкм, bточн=305 мкм, bр=350 мкм?
   а) 350 мкм
   б) 300 мкм
   в) 400 мкм
5. С определения какого параметра начинается расчет резистора с коэффициентом формы 10>Кф>1?
   а) с расчета ширины резистора, b
   б) с расчета длины резистора, l
   в) с расчета мощности резистора, P
6. При плавной подгонке сопротивления какой из надрезов обеспечивает «грубую»/ «плавную» подгонку?
   а) вдоль/поперек
   б) поперек/вдоль
   в) под углом
7. Максимальная толщина диэлектрической пленки для тонкопленочных конденсаторов составляет?
   а) 1 мкм
   б) 0,1 мкм
   в) 10 мкм
8. Какому классу чистоты должны соответствовать подложки, применяемые в полупроводниковых ИМС?
   а) 14
   б) 10
   в) 8
9. Какие виды изоляции относятся к комбинированному способу?
   а) изопланарная технология
   б) полипланарная технология

Согласована на портале № 84191

в) эпипланарная технология
г) декаль метод
д) метод балочных выводов
е) коллекторная изолирующая диффузия

10. Какая из операций по формированию полупроводниковой ИМС выполняется самой первой, при условии использования подложки с эпитаксиальным слоем?
а) формирование изолированных областей
б) формирование базы транзисторов
в) формирование эмиттеров транзисторов
г) формирование защитного слоя
д) формирование металлизации

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Подложки ГИС. Назначение. Требования к материалу подложек. Материалы подложек ГИС.
2. Материалы пленок тонкопленочных ИМС.
3. Конфигурации тонкопленочных резисторов. Расчет конструкции тонкопленочных резисторов.
4. Конструкции тонкопленочных резисторов с подгонкой сопротивления.
5. Конструкции пленочных конденсаторов. Ограничения при проектировании пленочных конденсаторов. Расчет пленочного конденсатора.
6. Конструкции подгоняемых тонкопленочных конденсаторов. Материалы тонкопленочных конденсаторов. Требования к материалам тонкопленочных конденсаторов.
7. Конструкции пленочных индуктивностей. Номиналы индуктивностей. Способы повышения номиналов индуктивностей.
8. Конструкции тонкопленочных распределенных RC-структур.
9. Навесные элементы ГИС.
10. Особенности проектирования СВЧ ГИС. Элементы СВЧ ГИС.
11. Характеристика основных этапов проектирования топологии.
12. Основные технологические операции изготовления толстопленочных гибридных микросхем.
13. Расчет конструкции толстопленочных резисторов.
14. Основные этапы теплового расчета ГИС. Зоны теплового влияния. Расчет зон теплового влияния.
15. Герметизация ИМС. Требования к герметизации. Типы корпусов.
16. Корпуса. Разварка корпуса. Способы разварки.
17. Корпуса. Герметизация корпусов сваркой.
18. Корпуса. Герметизация корпуса пайкой.
19. Корпуса. Бескорусная герметизация. Герметизация пластмассой.
20. Корпуса. Контроль герметизации корпусов.
21. Подложки полупроводниковых ИМС. Система условных обозначений полупроводниковых пластин.
22. Диэлектрические подложки полупроводниковых ИМС. Основные требования предъявляемые к материалу подложек. Система условных обозначений. Материалы для подложек.
23. Виды элементов, реализуемых в полупроводниковой технологии и способы их создания.
24. Интегральные транзисторы n-p-n. Конструкция, с указанием глубин залегания диффузионных областей. Этапы создания диффузионных областей транзистора, требования к их концентрации и размерам областей.
25. Интегральные транзисторы p-n-p. Конструкции p-n-p транзисторов. Основные недостатки p-n-p транзисторов и способы их устранения.
26. Многоэмиттерные транзисторы n-p-n. Конструкции, назначение. Основные проблемы при конструировании и способы их устранения.
27. Многоколлекторные транзисторы n-p-n. Конструкции, назначение, Основные проблемы при конструировании и способы их устранения.
28. Интегральная инжекционная логика И2Л с горизонтальным и вертикальным

Согласована на портале № 84191

инжектором. Основные достоинства. Назначение.
29. Инжекционно-полевая логика ИПЛ.
30. Интегральные диоды. Конструкции. Проблемы при создании интегральных диодов и способы их решения. Параметры диодов при различных конструкциях.
31. Диоды Шотки. Технологические трудности при создании диодов Шоттки и способы их решения. Материалы, используемые при изготовлении диодов Шоттки.
32. Транзисторы с диодами Шотки. Конструкции, назначение.
33. Интегральные резисторы. Конструкции, параметры.
34. Интегральные конденсаторы. Конструкции, параметры.
35. Методы изоляции элементов ИМС. Диодная изоляция.
36. Методы изоляции элементов ИМС. Коллекторная изолирующая диффузия.
37. Методы изоляции элементов ИМС. Базовая изолирующая диффузия.
38. Методы изоляции элементов ИМС. Метод самоизоляции n-областью.
39. Методы изоляции элементов ИМС. Изоляция тонкой пленкой диэлектрика.
40. Методы изоляции элементов ИМС. Декаль-метод.
41. Методы изоляции элементов ИМС. Метод балочных выводов.
42. Методы изоляции элементов ИМС. Метод кремний на сапфире.
43. Методы изоляции элементов ИМС. Изопланар.
44. Методы изоляции элементов ИМС. Полипланар.
45. Разработка топологии ИМС. Правила проектирования изолированных областей.
46. Разработка топологии ИМС. Правила размещения элементов ИМС на площади кристалла.
47. Интегральные микросхемы на МДП-транзисторах. Типы МДП-транзисторов. Комплементарная пара.
48. Запоминающие устройства на МДП-транзисторах.
49. Базовый матричный кристалл.

9.1.3. Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ

1. **Вариант 1**. Рассчитать размеры тонкопленочных резисторов. $\gamma_{\rho s}$=2% , $\gamma_{Rст}$=1%, $\gamma_{Rк}$=1%.

Резистор	Номинал, Ом	Допуск, %	Мощность рассеяния, мВт	Диапазон температур, ºС	Шаг координатной сетки, мм	Метод изготовления/ масштаб
R1	600	10	10	-60 ÷ +55	0.5	Ф
R2	10000	10	15			Масштаб
R3	125000	15	10			10:1

2. **Вариант 9**. Рассчитать размеры тонкопленочных резисторов. $\gamma_{\rho s}$=2% , $\gamma_{Rст}$=1%, $\gamma_{Rк}$=1%.

Резистор	Номинал, Ом	Допуск, %	Мощность рассеяния, мВт	Диапазон температур, ºС	Шаг координатной сетки, мм	Метод изготовления/ масштаб
R1	800	7	10	-30 ÷ +99	0.5	Ф
R2	5500	7	25			Масштаб
R3	80000	15	15			10:1

3. **Вариант 1**. Рассчитать размеры тонкопленочных конденсаторов. γ_{C0}=4% , $\gamma_{Cст}$=1%,

	Номинал, пФ	Частота, МГц	Допуск, %	Рабочее напряжение В	Диапазон температур, ºС	Шаг координатной сетки, мм	Метод изготовления/ масштаб
C1	80	5	15	10	-60 ÷ +70	1	М
C2	240		15	10			Масштаб
C3	650		15	15			10:1

4. **Вариант 10**. Рассчитать размеры тонкопленочных конденсаторов. γ_{C0}=4% , $\gamma_{Cст}$=1%,

	Номинал, пФ	Частота, МГц	Допуск, %	Рабочее напряжение В	Диапазон температур, ºС	Шаг координатной сетки, мм	Метод изготовления/ масштаб
C1	1200	1	15	10	-60 ÷ +85	1	М
C2	1600		15	15			Масштаб
C3	2000		15	15			10:1

Согласована на портале № 84191

5. **Вариант №1** Произвести тепловой расчет и рассчитать зоны теплового влияния для следующих элементов:

Элемент	l, мм	b, мм	Рэ, мВт	Rт внут, град/Вт	Tmax,°C
R1	1,5	0,6	15		125
R2	2	0,8	10		125
R3	0,8	1,7	15		125
R4	1,1	0,5	15		125
VT1	1	1	15	600	85

Элементы размещены на плате размером 10х15 мм и толщиной 0,45 мм. Конструктивный вариант ИМС- **вариант 4** со следующими параметрами: $h_{к1}$=100 мкм, $h_{к2}$=500 мкм, $\lambda_{к1}$=0,5 Вт/(м*град), $\lambda_{к2}$=0,5 Вт/(м*град), $\lambda_{п}$=1,5 Вт/(м*град). Транзистор VT1 расположен на резисторе R2. Температура окружающей среды Токр.ср.=-60 ÷ +60°С. Результаты расчета привести в виде таблицы:

6. **Вариант №11** Произвести тепловой расчет и рассчитать зоны теплового влияния для следующих элементов:

Элемент	l, мм	b, мм	Рэ, мВт	Rт внут, град/Вт	Tmax,°C
R1	1,3	0,4	10		125
R2	1,8	0,6	15		125
R3	0,8	1,7	10		125
R4	1,1	0,5	25		125
VT1	1,1	1,1	18	720	85

Элементы размещены на плате размером 10х15 мм и толщиной 0,7 мм. Конструктивный вариант ИМС- **вариант 3** со следующими параметрами: $h_{к1}$=100 мкм, $h_{к2}$=100 мкм, $\lambda_{к1}$=0,5 Вт/(м*град), $\lambda_{к2}$=0,5 Вт/(м*град), $\lambda_{п}$=1,5 Вт/(м*град). Транзистор VT1 расположен на резисторе R1. Температура окружающей среды Токр.ср.=-60 ÷ +55°С. Результаты расчета привести в виде таблицы:

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

Конспектирование студентами лекционного материала обязательно. Обязательным условие допуска к экзамену является выполнение и защита всех лабораторных работ, а также написание контрольных работ на положительную оценку

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Согласована на портале № 84191

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;
– в печатной форме с увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– методом чтения ассистентом задания вслух;
– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;
– набор ответов на компьютере;
– набор ответов с использованием услуг ассистента;
– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 84191

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФЭ
протокол № 172 от «16» 10 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ИРЭТ	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52
Заведующий обеспечивающей каф. ФЭ	Ю.В. Сахаров	Согласовано, dd1f7cbe-1ce6-48e6-b40d-074633a5bd8a
Начальник учебного управления	Г.А. Цой	Согласовано, 8a5745e4-63a0-4946-bbb0-ce4977ac113e

ЭКСПЕРТЫ:

Заведующий кафедрой, каф. СВЧиКР	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52
Доцент, каф. ФЭ	И.А. Чистоедова	Согласовано, 2114f42c-7cf2-4826-9f35-9a75ea4961b2

РАЗРАБОТАНО:

Профессор, каф. ФЭ	Ю.В. Сахаров	Разработано, dd1f7cbe-1ce6-48e6-b40d-074633a5bd8a

Согласована на портале № 84191